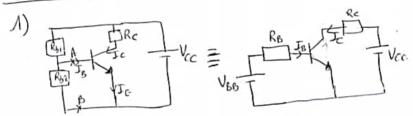
Exercice1



En utilisant le th. de Thévenin entre Aet 8: $R_B = R_{B1} IIR_{B2} = \frac{R_{B1}R_{B2}}{R_{B1} + R_{B1}}$ et $E_{H1} = V_{B6} = \frac{R_{B2}}{R_{62} + R_{B1}} V_{CC}$.

2 - Equation des droits de charge Statique.

A l'entrée VBB = RBIB+VBE => IB = VBB-VBE

RB

En Sortie Vcc = RcIc + VcE => Ic = Vcc - Vce

Re.

Point de blocage: $I_B=0$, $I_C=0$; $V_{BE}=V_{BB}$, $V_{CE}=V_{CC}$) Point de Sahusahon: $\left(V_{CE}=0$, $I_C=0$, $I_{CE}=0$,

3- Point de fonctionnement: [RBI = 16KA, RBZ = 1KA, Rc = 24OA JIB = 100MA = 0,1MA. VBE? Ic? VEF = 6V.

VBE = VBB - RBIB OF VBB = RBI Vcc 20,7V.
d'sà VBE = 0,7-9,09420,6V.

Ic = Vec - VCE = 25 mA.

La jonchion collecteur-Base est polarisée en inverse: VBC = VBE + VEC = VBE - VCE = -5,4VCO.

B = Ic = 250 et d = B = 0,996.



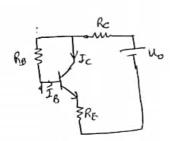
1- IB - 200 4 4 = 10/900

(1/5)

Transister Socheré $V_{CE=0}$, $J_{C=0}$, $V_{CE=1}$ V_{CC} (Circuit puwert Transister Socheré $V_{CE=0}$) $J_{C=0}$, $V_{CE=0}$ (C.C. entre Cet C),

Sèrce 5: Exercice 2.

· VBE = 0, B; B=65, Uo = 100; RB = 17KR; Rc=1KR; RE=1002



Distribute the Charge Stangue on Sorho

$$I) U_0 = R_c I_E + V_{CE} + R_E I_E$$

$$= (R_c + R_E) I_E + V_{CE}$$

$$\Rightarrow I_E = \frac{U_0 - V_{CE}}{R_c + R_E} \text{ if } I_c \cong I_E$$

2- Droite de chargo statique en entreé

D'après la caractérishque $V_{BE_0} = 0,6V =$) $I_B \simeq 106\mu A$. Point de fonchiennement ($V_{BE_0} = 0,6V$, $I_{B_0} = 106\mu A$; I_{C_0} ?, V_{CE_0} ?) $I_{C_0} = \beta I_B = 6,9 \text{ mA}$.; $I_{E_0} = (\beta_1 A) I_{B_0} \simeq 7 \text{ mA}$.

3- VCE = 5V; Uo = 10V, Rg = 17KJ .-
Trace do la discitedo charge en Sortie: Fe = Uo - VCE

| Jc = 0 => VCE = Uo = 10V

| VCE = 0 => Jc = Uo = SmA.

Power $V_{CE} = 5V$ on a $I_c = \frac{10-5}{1100} \approx 4,54 \text{ mA}$. $I_B = \frac{J_c}{\beta} = 70 \mu \text{A}$. $V_{BE} = 0,6V$.



1) B | = | h12 = 0.; h1 = B. 2- $f_0 = 1 \text{KHz}$. $C_A = C_2 = 100 \mu \text{Fel} C_E = 220 \mu \text{F}$. $|Z_{cd}| = \frac{1}{C_2 \omega} = \frac{1}{2 \pi f C_4} = Z_{ce}$. A.N: $Z_{ce} = Z_{ce} = 1,652$. $|Z_{ce}| = \frac{1}{C_2 \omega} = \frac{1}{2 \pi f C_4} = Z_{ce}$. A cette fréquence, les capacité perwent être considérées comme des court-circuits (fils) 3- Reg Ve Vbe = hin ib+hite = hin ib

Reg Vs \(\frac{1}{2} \text{ic} = \hin ib+hite = \hin ib

Reg Ve \(\frac{1}{2} \text{ic} = \hin ib+hite = \hin ib

Reg Ve \(\frac{1}{2} \text{ic} = \hin ib a - Amplification en tension.

* gain du transister: Aut = Vs = - Roie = - BRe * goun du Montage: Av = Vs - Vs , Ve . Ve = his is or is = RB ie (diviseur do courant) et le = Rg + (Rg//hn) d'où l'b = RB + Rg + (Rg//hn) eq. ib = RB+hin Rg(RB+hin)+RBhin eg On en déduit: Ve - hn RB Rg(RB+hn)+RBhn A.N: Aux = 470 . Au:



Exercice3. Suite

b- Amplification en courant.

y gain en courant du housister: Ait = 1c - B = 100.

or ib = RB ie d'où Ai = BRB Ra+hi

A.N: A: 250.

c- Impédance d'entreé

* Ze du transistor: Zet = Ue = Uhe = hir (A.N. Zet = 1Kr.,

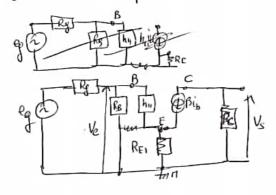
de Fe montage: Ze = Re + (Rollhy) (Ze = 0,5 Kr)

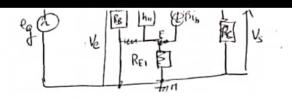
d - Impédance de Sortie

+ Z_{st} du transistor: Z_{st} = R_g + k₁₁ - 1
Z_{st} =
$$\frac{v_{ce}}{L_c} \approx \frac{1}{h_{22}} \Rightarrow \infty$$

& Zsm du montage: Zsm= Us = Rc 1/Zst 2 Rc.

5- CE est branche au point Es.







Amplification en lension:

$$A_{0} = \frac{V_{e}}{V_{e}} \text{ or } V_{s} = -Re \text{ i.e.} - \beta \text{ Re i.h.}$$

$$V_{e} = V_{be} = h_{11} i_{b} + Res (\text{ i.e.} + \text{ i.h.})$$

$$= [h_{11} + Res (\text{ i.h.} + \text{ i.h.})] i_{b}$$

$$A_{0} = \frac{V_{s}}{V_{e}} - \frac{\beta \text{ Re}}{h_{11} + Res (\text{ i.h.} + \text{ i.h.})} = -AO$$

On en déduit que : $\beta \text{ Re} = 10 (h_{11} + \beta \text{ Res})$

$$(\frac{\beta \text{ Re}}{10} - h_{11}) \times \frac{A}{\beta} = \text{ Res}.$$

$$A \cdot N : R_{EA} \approx 160052.$$



Le rôle de la résistance Re est de stabiliser le transistor en régime statique mais on remarque que le gain en tension diminue c'est pour cela qu'on découple Re avec une capacité